

内置 MOSFET 锂电池保护芯片 RB425A

概述

RB425A 是一款内置 MOSFET 的单节锂电池保护芯片。该芯片具有非常低的功耗和非常低阻抗的内置 MOSFET。该芯片有充电过压，充电过流，放电过压，放电过流，过热，短路等各项保护等功能，确保电芯安全，高效的工作。

RB425A 采用 DFN2X2-6 封装，外围只需要一个电阻和一个电容，应用极其简洁，工作安全可靠。

特性

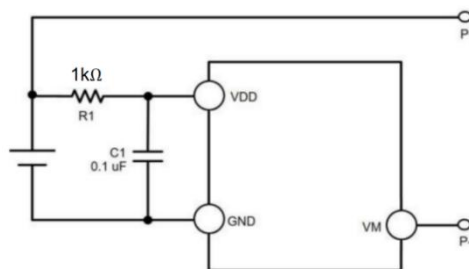
- 1 内置 24 mΩ MOSFET
- 2 超小超薄 DFN2X2-6 封装
- 3 内置过温保护
- 4 二重过放电流检测保护
- 5 超小静态电流和休眠电流
 - A 静态工作电流为 2.2 uA
 - B 休眠电流为 0.6 uA
- 6 符合欧洲“ROHS”标准的无铅产品

应用

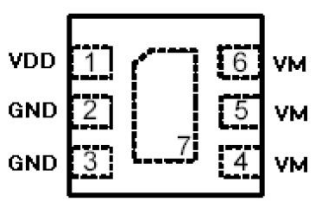
单节锂离子可充电电池组

单节锂聚合物可充电电池组

典型应用图



封装和引脚

 DFN2x2-6	管脚	符号	管脚描述
	1	VDD	电源端
	2, 3	GND	芯片地，接电池芯负极
	4, 5, 6	VM	充电器负电压接入端
	7	EPAD	接芯片地

订货信息

型号	封装	过充检测电压 (V)	过充解除电压 (V)	过放检测电压 (V)	过放解除电压 (V)	过流检测电流 (A)	打印标记
RB425A	DFN2X2-6	4.44	4.25	2.50	3.0	7.0	R425a xxxx

注意：xxxx 为字母和数字，用于产品批次识别。

内置 MOSFET 锂电池保护芯片 *RB425A*

原理图

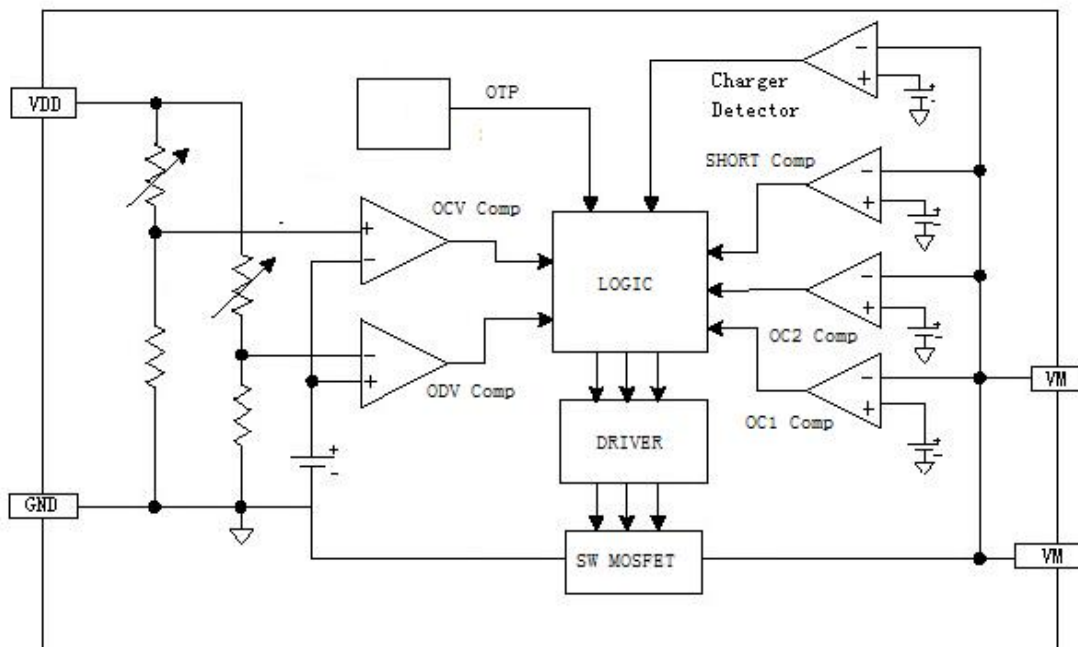


Figure 2. 原理图

绝对最大额定值

参 数	符 号	最小值	最大值	单 位
供电电压 (VDD 和 GND 间电压)	VDD	-0.3	8.0	V
充电器输入电压 (VM 和 GND 间电压)	VM	-5	10.0	V
存贮温度范围	TSTG	-55	145	°C
结温	TJ	-40	145	°C
功率损耗 T=25° C	PMAX		600	mW

注：各项参数若超出“绝对最大值”的范围，将有可能对芯片造成永久性损伤。以上给出的仅是极限范围，在这样的极限条件下工作，芯片的技术指标将得不到保证。长期工作在“绝对最大值”附近，会影响到芯片的可靠性。

推荐工作条件

参 数	符 号	最小值	最大值	单 位
供电电压 (VDD 和 GND 间电压)	VDD	0	6.0	V
充电器输入电压 (VM 和 GND 间电压)	VM	-4	6	V
存贮温度范围	TSTG	-40	85	°C

内置 MOSFET 锂电池保护芯片 **RB425A**

电器参数

除非特殊说明, $T_A = 27^{\circ}\text{C}$, $V_{DD}=3.7\text{V}$

项目	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
检测电压						
过充检测电压	VOCV		4.40	4.44	4.48	V
过充解除电压	VOCR		4.18	4.25	4.32	V
过放检测电压	VODV		2.40	2.50	2.60	V
过放解除电压	VODR		2.9	3.0	3.1	V
检测电流						
过放电流检测 1	IOCI1		6.0	7.0	8.5	A
短路电流检测	ISHORT		10	14	18	A
充电电流检测	ICHA		5.0	7.5	10.0	A
电流损耗						
工作电流	IOPE			2.2	5	μA
休眠电流	IPDN	$V_{DD}=1.8\text{V}$		0.6	1.5	μA
VM 上下拉电流						
内部上拉电流	IPU			7		μA
内部下拉电流	IPD	$V_M=1.0\text{V}$		7		μA
FET 内阻						
VM 到 GND 内阻	RDS(ON)	$I_{VM}=1.0\text{A}$	23	24	26	$\text{m}\Omega$
过温保护						
过温保护检测温度	TSHD			150		$^{\circ}\text{C}$
过温保护释放温度	TSHR			120		
检测延时						
过充检测电压延时	TOCV			100		mS
过放检测电压延时	TODV			100		mS
过放电流 1 检测延时	TI OV1			6		mS
短路电流检测延时	TSHORT			150		μS

内置 MOSFET 锂电池保护芯片 **RB425A**

功能描述

RB425A 监控电池的电压和电流，并通过断开充电器或者负载，保护单节可充电锂电池不会因为过充电压、过放电压、过放电流以及短路等情况而损坏。这些功能都使可充电电池工作在指定的范围内。该芯片仅需一颗外接电容和一个外接电阻，MOSFET 已内置，等效电阻的典型值为 $24\text{ m}\Omega$ 。

RB425A 支持四种运行模式：正常工作模式、充电工作模式、放电工作模式和休眠工作模式。

1. 正常工作模式

如果没有检测到任何异常情况，充电和放电过程都将自由转换。这种情况称为正常工作模式。

2. 过充电压情况

在正常条件下的充电过程中，当电池电压高于过充检测电压 (V_{ocv})，并持续时间达到过充电压检测延迟时间 (T_{ocv}) 或更长，RB425A 将控制 MOSFET 以停止充电。这种情况称为过充电压情况。如果异常情况在过充电压检测延迟时间 (T_{ocv}) 内消失，系统将不动作。

以下两种情况下，过充电压情况将被释放：

- (1). 充电器连接情况下，VM 端的电压低于充电器检测电压 V_{cha} ，电池电压掉至过充释放电压 (V_{ocr})。
- (2). 充电器未连接情况下，电池电压掉至过充检测电压 (V_{ocv})。当充电器未被连接时，电池电压仍然高于过充检测电压，电池将通过内部二极管放电。

3. 过放电流情况

在充电工作模式下，如果电流的值超过 I_{cha} 并持续一段时间 (T_{oci1}) 或更长，芯片将控制 MOSFET 以停止充电。这种情况被称为过放电流情况。RB425A 将持续监控电流

状态，当连接负载或者充电器断开，芯片将释放过放电流情况。

4. 过放电压情况

在正常条件下的放电过程中，当电池电压掉至过放检测电压 (V_{odv})，并持续时间达到过放电压检测延迟时间 (T_{odv}) 或更长，RB425A 将切断电池和负载的连接，以停止放电。这种情况被称为过放电压情况。当放电控制 MOSFET 被截止，内部上拉电流管打开。当 VDD 电压小于等于 $2.0V$ (典型值)，电流消耗将降低至休眠状态下的电流消耗 (I_{pdn})。这种情况被称为休眠情况。当 VDD 电压等于 $2.2V$ (典型值) 或更高时，休眠条件将被释放。并且，电池电压大于等于过放检测释放电压 (V_{odr}) 时，RB425A 将回到正常工作条件。

5. 过放电流情况 (过放电流1和过放电流2的检测) 如果放电电流超过额定值，且持续时间大于等于过放电流检测延迟时间，电池和负载将被断开。如果在过放电流检测延迟时间内，电流又降至额定值范围之内，系统将不动作。芯片内部下拉电流下拉 VM，当 VM 的电压小于或等于过放电流1的参考电压，过放电流状态将被复位。

6. 负载短路电流情况

若 VM 管脚的电压小于等于短路保护电压 (V_{short})，系统将停止放电电池和负载的连接将断开。 T_{short} 是切断电流的最大延迟时间。当 VM 的电压小于或等于过放电流1的参考电压，负载短路状态将被复位。

7. 充电器检测

当处于过放电状态下的电池和充电器相连，若 VM 管脚电压小于等于充电器检测电压 V_{cha} ，当电池电压大于等于过放检测电压 V_{odv} ，RB425A 将释放过放电状态。

内置 MOSFET 锂电池保护芯片 RB425A

时序图

1. 过充(OCV) → 放电 → 正常工作

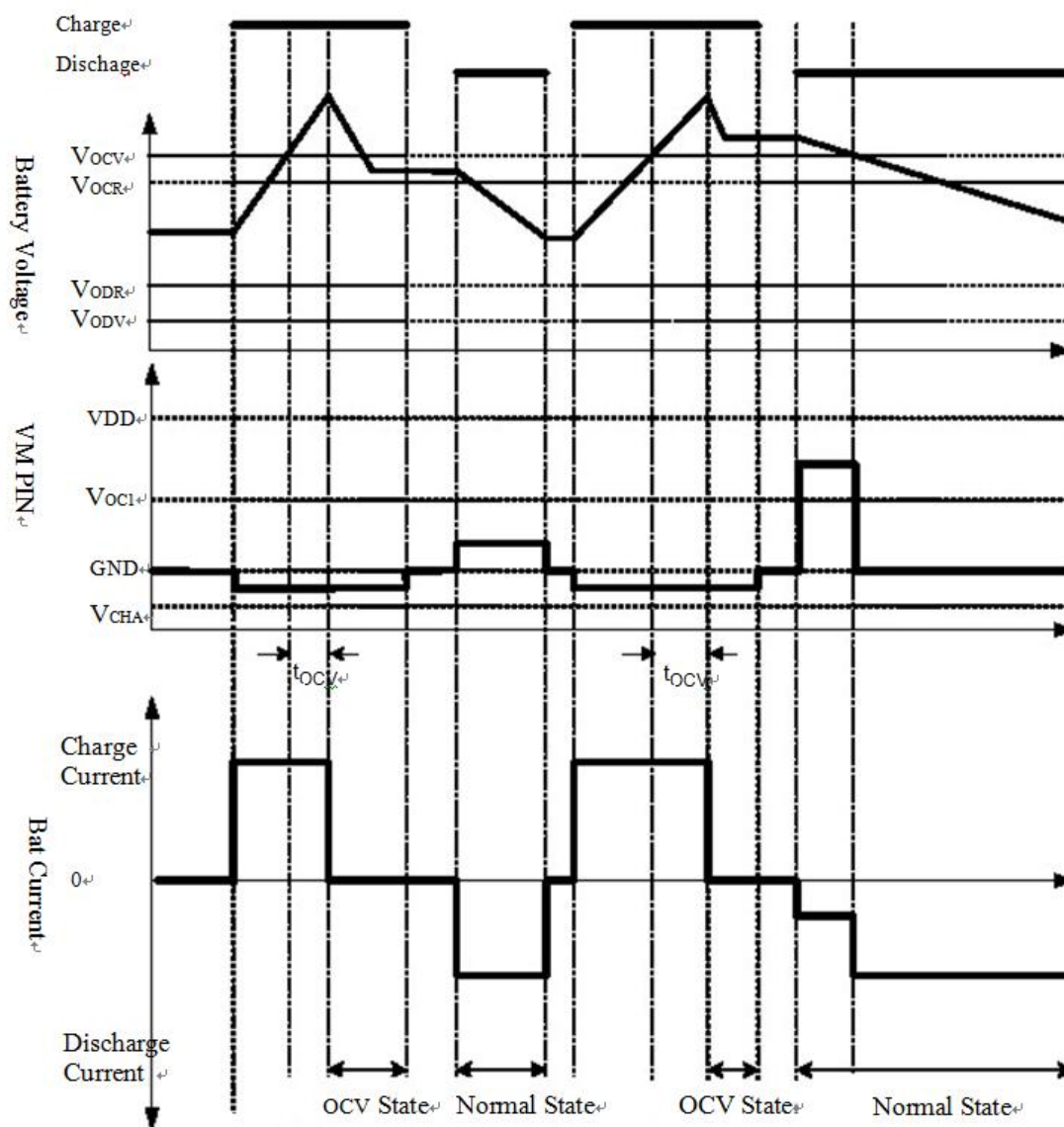


Figure 3. 充电，放电，正常工作时序图

内置 MOSFET 锂电池保护芯片 RB425A

2. 过放(ODV) → 充电 → 正常工作

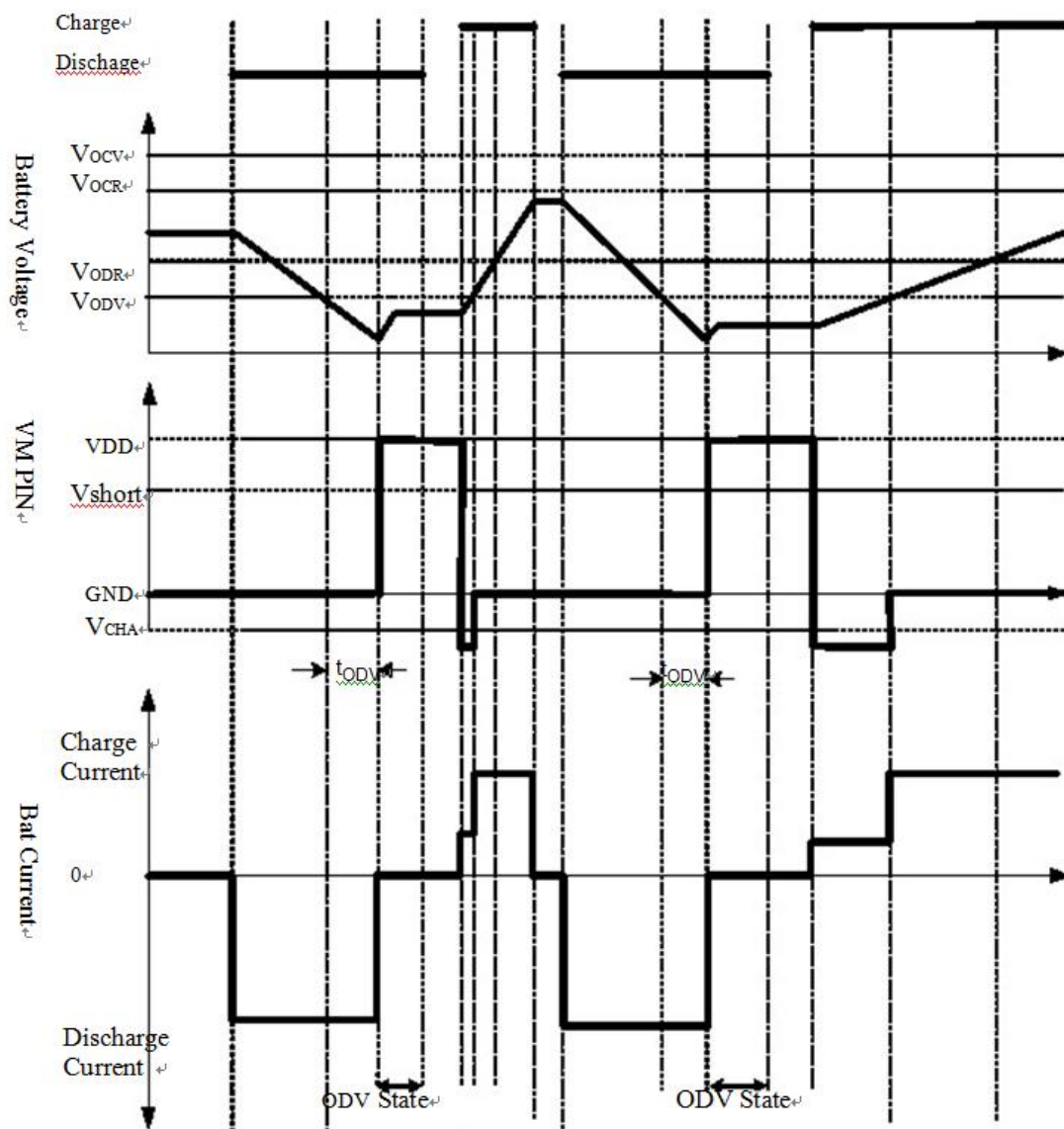


Figure 4. 过放, 充电和正常工作时序图

内置 MOSFET 锂电池保护芯片 RB425A

3. 放电过流 (ODC) → 正常工作

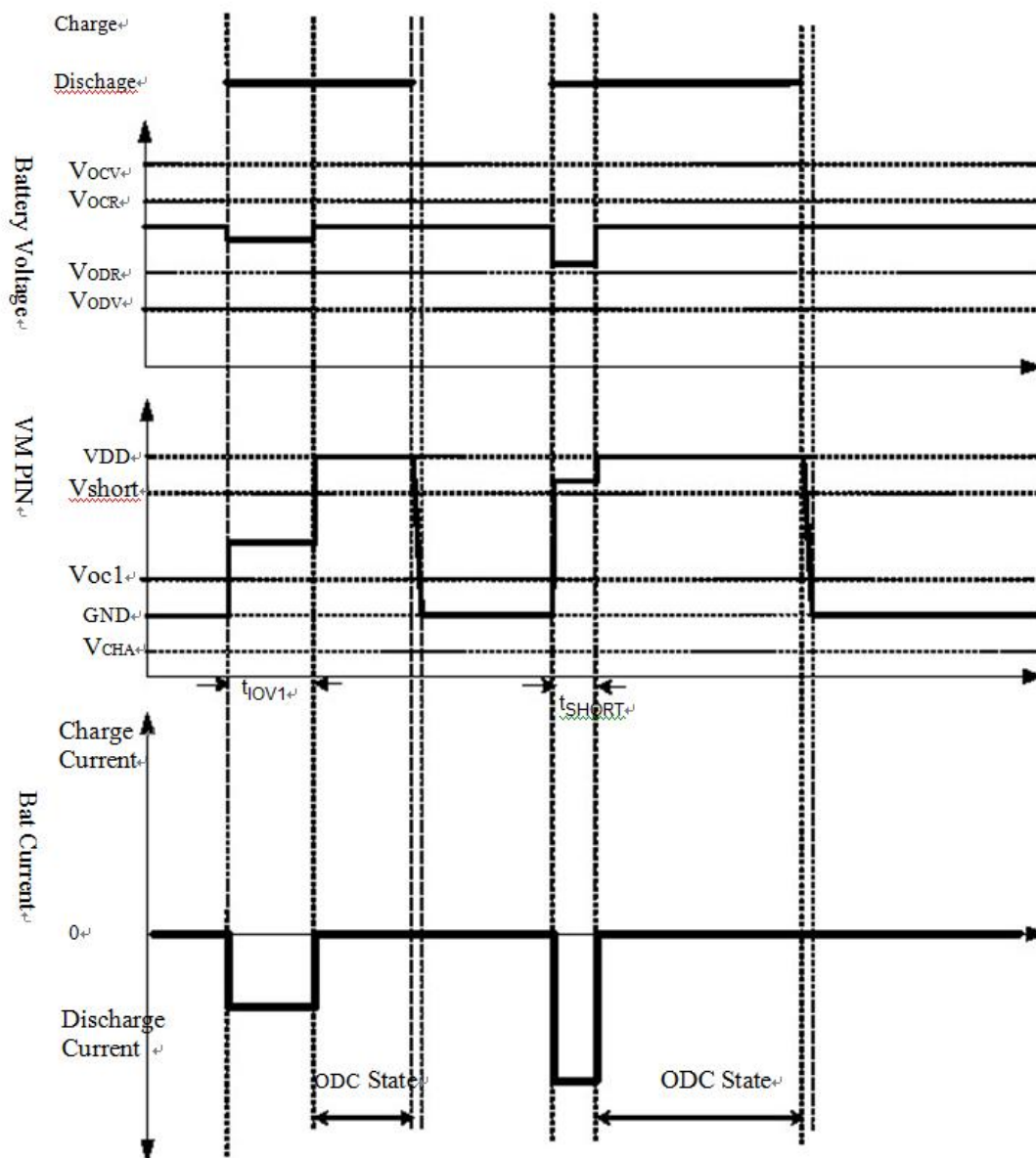
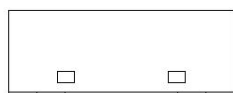
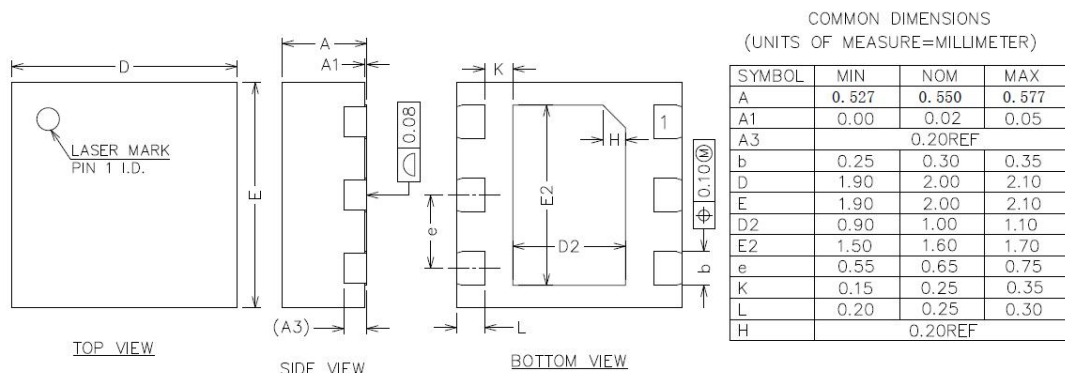


Figure 6. 放电过流和正常工作时序图

内置 MOSFET 锂电池保护芯片 **RB425A**

PACKAGE OUTLINE



SIDE VIEW

NOTES:
ALL DIMENSIONS REFER TO JEDEC STANDARD MO-229
DO NOT INCLUDE MOLD FLASH OR PROTRUSIONS.